

レーザー研究

第52巻第5号 (2024年5月)

「過酷な高温環境に耐える半導体レーザー」特集号

レーザーコンパス レーザー研究の個人的な思い出とこれから 欠端 雅之 (231)

特 集

レーザー解説 「過酷な高温環境に耐える半導体レーザー」特集号によせて 荒井 昌和 (232)
量子ドットレーザーの高温環境動作 角田 雅弘, 荒川 泰彦 (233)
SiC 単結晶基板上直接変調メンブレンレーザー 山岡 優, 松尾 慎治 (238)
超高温度安定性量子カスケードレーザー 藤田 和上 (243)
GaAs 基板上 1.3 μm 帯 “W” 型 Type-II 量子井戸レーザーの温度特性 冬木 琢真, 呉 剛志, 吉永 弘幸, 吉本 晋 (248)
GaAs 基板上メタモルフィック InGaAs 量子井戸レーザーの高温動作 荒井 昌和 (253)

レーザーフラッシュ
研究室紹介 東京情報デザイン専門職大学情報デザイン学部 情報デザイン学科河合研究室 (258)
著者紹介 (259)
セルフフォーカス (261)
レーザーワード (242)

